

Silicon Dual Schottky Diode

S455D

6V / 200mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

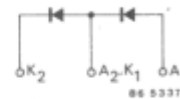
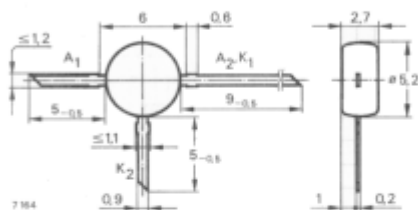
Source: Telefunken Databook 1988

S 455 D**GaAs-Schottky Diodenpaar**

Vorläufige technische Daten für Muster

Anwendung: Ringmodulatoren**Besondere Merkmale:**

- Geringe Durchlaßspannung
- Geringer Durchlaßwiderstand
- Geringe Durchlaßspannungs-
differenzen
- Geringe Kapazitäten

Abmessungen in mm

Standard Kunststoffgehäuse
50 B3 DIN 41867
JEDEC TO 50
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

für Einzeldiode falls nicht anders angegeben

Sperrspannung	U_R	6	V
Spitzendurchlaßstrom	I_{FM}	200	mA
Gesamtverlustleistung $T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	200	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	125	$^\circ\text{C}$
Umgebungstemperaturbereich	T_{amb}	-55...+125	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-55...+125	$^\circ\text{C}$

Kenngrößen

für Einzeldiode

		Min.	Typ.	Max.
Sperrstrom $U_R = 4\text{ V}$	I_R			50 μA
Durchlaßstrom	I_F			200 mA
Durchlaßspannung $I_F = 1\text{ mA}$	U_F	620		mV
$I_F = 10\text{ mA}$	U_F			820 mV
Differentieller Durchlaßwiderstand $I_F = 5\text{ mA}$	r_f			15 Ω
Diodenkapazität $U_R = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_D		700	fF

S 455 D

